



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

H1302

对应国外型号
KTD1302

主要用途

开关作用。

极限值 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

T_{stg} ——贮存温度.....	-55~150
T_j ——结温.....	150
P_C ——集电极耗散功率.....	400mW
V_{CBO} ——集电极—基极电压.....	25V
V_{CEO} ——集电极—发射极电压.....	20V
V_{EBO} ——发射极—基极电压.....	12V
I_C ——集电极电流.....	300mA
I_B ——基极电流.....	30mA

外形图及引脚排列

TO-92



1—发射极, E
2—集电极, C
3—基极, B

电参数 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			100	nA	$V_{\text{CB}}=25\text{V}, I_{\text{E}}=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			100	nA	$V_{\text{EB}}=12\text{V}, I_{\text{C}}=0$
H_{FE}	直流电流增益	200		800		$V_{\text{CE}}=2\text{V}, I_{\text{C}}=4\text{mA}$
$V_{\text{CE(sat)}}$	集电极—发射极饱和电压			0.25	V	$I_{\text{C}}=100\text{mA}, I_{\text{B}}=10\text{mA}$
$V_{\text{BE(sat)}}$	基极—发射极饱和电压			1.0	V	$I_{\text{C}}=100\text{mA}, I_{\text{B}}=10\text{mA}$
f_{T}	特征频率		60		MHz	$V_{\text{CE}}=10\text{V}, I_{\text{C}}=1\text{mA}$
C_{ob}	共基极输出电容		10		pF	$V_{\text{CB}}=10\text{V}, I_{\text{E}}=0, f=1\text{MHz}$

分档及其标志

A

B

C

200—350

300—500

400—800